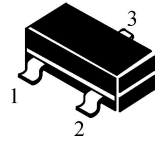


MMBTA94

SOT-23

- 1. BASE
- 2. EMITTER
- 3. COLLECTOR



## ■ FEATURES 特點

## ■ MAXIMUM RATINGS 最大額定值

Characteristic 特性參數	Symbol 符號	Rating 額定值	Unit 單位
Collector-Emitter Voltage 集電極-射極電壓	$V_{CEO}$	-400	V
Collector-Base Voltage 集電極-極電壓	$V_{CBO}$	-400	V
Emitter-Base Voltage 發射極基極電壓	$V_{EBO}$	-7	V
Collector Current 集電極電流	$I_c$	-200	mA
Device Dissipation 耗散功率	$P_D$	225	mW
Junction and Storage Temperature 結溫和儲存溫度	$T_J, T_{stg}$	-55to+125	°C

## ■ DEVICE MARKING 打標

MMBTA94=4D



MMBTA94

## ■ ELECTRICAL CHARACTERISTICS 電特性

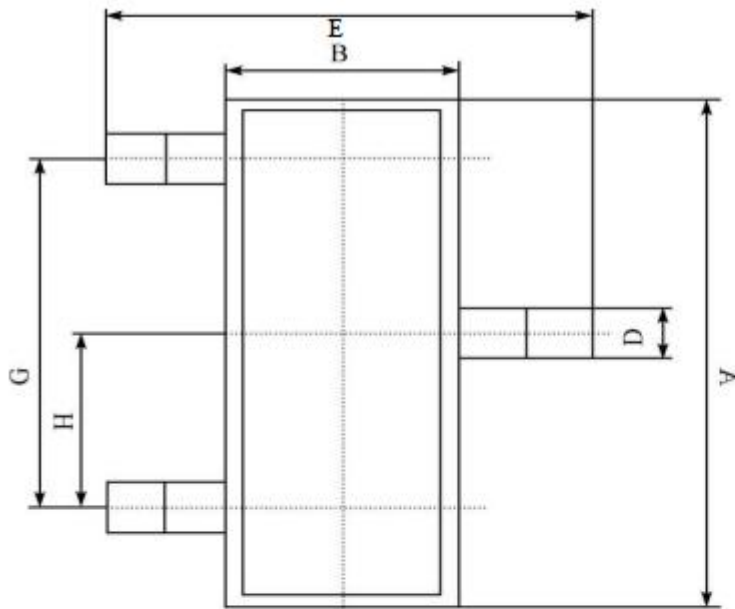
( $T_A=25^{\circ}\text{C}$  unless otherwise noted 如無特殊說明，溫度為  $25^{\circ}\text{C}$ )

Characteristic 特性參數	Symbol 符號	Min 最小值	Max 最大值	Unit 單位
Collector-Emitter Breakdown Voltage 集電極-射極擊穿電壓( $I_C=-1\text{mA}, I_B=0$ )	$V_{(BR)CEO}$	-400	—	V
Collector-Base Breakdown Voltage 集電極-基極擊穿電壓( $I_C=-100\mu\text{A}, I_E=0$ )	$V_{(BR)CBO}$	-400	—	V
Emitter-Base Breakdown Voltage 發射極-基極擊穿電壓( $I_E=-100\mu\text{A}, I_C=0$ )	$V_{(BR)EBO}$	-7	—	V
Collector Cutoff Current 集電極截止電流 ( $V_{CB}=-400\text{V}, I_E=0$ )	$I_{CBO}$	—	-500	nA
DC Current Gain 直流電流增益 ( $I_C=-10\text{mA}, V_{CE}=-10.0\text{V}$ )	$H_{FE}$	40	240	—
Collector-Emitter Saturation Voltage 集電極-發射極飽和壓降 ( $I_C=-20\text{mA}, I_B=-2\text{mA}$ )	$V_{CE(sat)}$	—	-0.6	V
Current-Gain-Bandwidth Product 電流增益帶寬乘積 ( $I_C=-10\text{mA}, V_{CE}=-20\text{V}, f=30\text{MHz}$ )	$f_T$	50	—	MHz

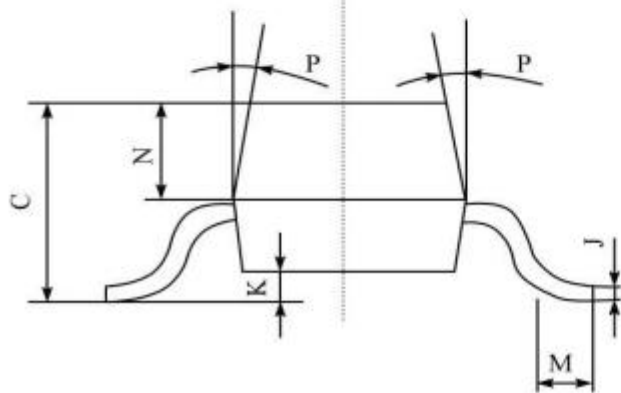
MMBTA94

■ DIMENSION 外形封裝尺寸

單位(UNIT): mm



代碼	範圍(單位:mm)
A	2.80~3.00
B	1.20~1.40
C	0.90~1.10
D	0.30~0.50
E	2.20~2.60
G	1.80~2.00
H	0.90~1.00
J	0.08~0.18
K	0.02~0.12
M	≥0.22
N	0.50~0.70
P	6°~10°



单击下面可查看定价，库存，交付和生命周期等信息

[>>FOSAN\(富信\)](#)